【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年3月10日(2016.3.10)

【公表番号】特表2015-512149(P2015-512149A)
【公表日】平成27年4月23日(2015.4.23)
【年通号数】公開・登録公報2015-027
【出願番号】特願2014-555829(P2014-555829)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/02　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/265　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　31/18　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　31/0747　(2012.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/02　Ｃ
Ｈ０１Ｌ　21/265　Ｑ
Ｈ０１Ｌ　31/04　４６０
Ｈ０１Ｌ　31/06　４５５

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月21日(2016.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子装置を形成する方法であって、前記方法は、
ａ．　上面を含むドナー本体を設けるステップと、
ｂ．　劈開面を形成するために、ドナー本体の上面にイオン投与量を注入するステップと、
ｃ．　ドナー本体から薄層を剥離するステップとを含み、薄層を剥離するステップは薄層の第１の表面を形成し、ドナー本体の上面は薄層の第２の表面になり、第１の表面は第２の表面の反対側にあり、薄層は、第１の表面と第２の表面との間の厚さが２～４０ミクロンであり、薄層は第１の熱膨脹係数を有し、前記方法はさらに、
ｄ．　剥離するステップの後に、薄層上にフレキシブル金属支持体を構成するステップを含み、フレキシブル金属支持体は第２の熱膨脹係数を有し、第２の熱膨脹係数は、１００～６００℃の温度で、薄層の第１の熱膨脹係数の１０％以内である、方法。
【請求項２】
ドナー本体から電子装置を生産する方法であって、前記方法は、
ａ．　第１の側と、第１の側とは反対側の第２の側と、第１の側と第２の側との間の厚さと、第１の熱膨脹係数とを有し、厚さは４０μｍ未満である薄層を設けるステップと、
ｂ．　薄層の第１の側を一時的担体に接触させるステップと、
ｃ．　薄層の第２の側上に、ニッケル鉄合金を含むフレキシブル金属支持体を構成するステップとを含み、フレキシブル金属支持体は、摂氏１００～６００度の温度で、薄層の第１の熱膨脹係数の１０％以内である第２の熱膨脹係数を有し、前記方法はさらに、
ｄ．　薄層とフレキシブル金属支持体とを含む電子装置を形成するステップを含む、方法。
【請求項３】

電子装置であって、

ａ．　半導体薄層を含み、薄層は、２ミクロン～４０ミクロンの厚さを有し、薄層は、第１の表面と、第１の表面とは反対側の第２の表面とを有し、薄層は第１の熱膨脹係数を有し、前記電子装置はさらに、

ｂ．　第１の表面上または上方に構成された金属支持体要素を含み、金属支持体要素は、ニッケルを含む第１の金属層と、ニッケル、鉄、コバルト、またはそれらの任意の組合せを含む第２の金属層とを含み、金属支持体要素は第２の熱膨脹係数を有し、薄層の第１の熱膨脹係数および金属支持体の第２の熱膨脹係数は、１００～６００℃の温度で、互いの１０％以内である、電子装置。